

10 / 530026

JP2004/011763

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

19.08.2004

04 APR 2005

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2003年 8月22日
Date of Application:

出願番号 特願2003-298671
Application Number:
[ST. 10/C]: [JP2003-298671]

REC'D 07 OCT 2004

WIPO

PCT

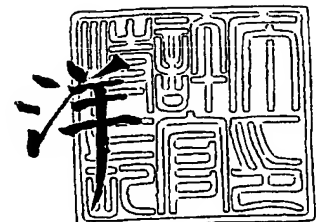
出願人 三菱電機株式会社
Applicant(s):

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 9月24日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小川



BEST AVAILABLE COPY

出証番号 出証特2004-3085818

【書類名】 特許願
【整理番号】 547104JP01
【提出日】 平成15年 8月22日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 H01L 21/268
H01L 21/20
H01L 29/786

【発明者】
【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 3 号 三菱電機株式会社内
【氏名】 井上 満夫

【発明者】
【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 3 号 三菱電機株式会社内
【氏名】 時岡 秀忠

【発明者】
【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 3 号 三菱電機株式会社内
【氏名】 由良 信介

【特許出願人】
【識別番号】 000006013
【氏名又は名称】 三菱電機株式会社

【代理人】
【識別番号】 100064746
【弁理士】
【氏名又は名称】 深見 久郎

【選任した代理人】
【識別番号】 100085132
【弁理士】
【氏名又は名称】 森田 俊雄

【選任した代理人】
【識別番号】 100083703
【弁理士】
【氏名又は名称】 仲村 義平

【選任した代理人】
【識別番号】 100096781
【弁理士】
【氏名又は名称】 堀井 豊

【選任した代理人】
【識別番号】 100098316
【弁理士】
【氏名又は名称】 野田 久登

【選任した代理人】
【識別番号】 100109162
【弁理士】
【氏名又は名称】 酒井 將行

【手数料の表示】
【予納台帳番号】 008693
【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】
【物件名】 特許請求の範囲 1
【物件名】 明細書 1
【物件名】 図面 1

【物件名】

要約書 1

【書類名】 特許請求の範囲

【請求項 1】

可視光パルスレーザを被照射物の表面に線形状に集光して、この線形状の照射領域の幅方向に次のタイミングの照射領域を重ね合わせるようにして位置をずらしながら繰返し照射して前記被照射物の表面に多結晶シリコン膜を形成する多結晶化工程を含み、

前記多結晶化工程は、前記可視光パルスレーザが第 1 の照射領域に照射されている間または照射される前に前記第 1 の照射領域に部分的に重なる第 2 の照射領域に紫外光パルスレーザを照射する、薄膜半導体の製造方法。

【請求項 2】

前記被照射物を一方向に相対的に移動させながら、前記第 2 の照射領域が前記第 1 の照射領域に比べて前記被照射物の進行方向後ろ側に位置するように、前記可視光パルスレーザおよび前記紫外光パルスレーザを照射する、請求項 1 に記載の薄膜半導体の製造方法。

【請求項 3】

前記可視光パルスレーザとして Nd:YAG の第 2 高調波を用い、前記紫外光パルスレーザとして Nd:YAG の第 2 高調波よりもさらに波長の短い高調波を用いる、請求項 1 または 2 に記載の薄膜半導体の製造方法。

【請求項 4】

被照射物の表面に多結晶シリコン膜を形成するために、可視光パルスレーザを前記被照射物の表面に線形状に集光して、この線形状の照射領域の幅方向に次のタイミングの照射領域を重ね合わせるようにして位置をずらしながら繰返し照射する可視光パルスレーザ照射手段と、

前記可視光パルスレーザが第 1 の照射領域に照射されている間または照射される前に前記第 1 の照射領域に部分的に重なる第 2 の照射領域に紫外光パルスレーザを照射する紫外光パルスレーザ照射手段とを備える、薄膜半導体の製造装置。

【請求項 5】

前記被照射物を一方向に相対的に移動させる被照射物移動手段と、

前記第 2 の照射領域が前記第 1 の照射領域に比べて前記被照射物の進行方向後ろ側に位置するように設定する照射領域差別化手段とを備える、請求項 4 に記載の薄膜半導体の製造装置。

【請求項 6】

前記可視光パルスレーザとして Nd:YAG の第 2 高調波を照射し、前記紫外光パルスレーザとして Nd:YAG の第 2 高調波よりもさらに波長の短い高調波を照射することができる、請求項 4 または 5 に記載の薄膜半導体の製造装置。

【請求項 7】

前記可視光パルスレーザと前記紫外光パルスレーザとが同一の光軸上を進むように前記可視光パルスレーザおよび前記紫外光パルスレーザを伝送するレーザ伝送部と、

前記レーザ伝送部において前記可視光パルスレーザと前記紫外光パルスレーザとの出射角度に差をつけるために前記光軸を挟んで互いに対称な位置関係で配置されたプリズムとを備える、請求項 4 から 6 のいずれかに記載の薄膜半導体の製造装置。

【書類名】明細書

【発明の名称】薄膜半導体の製造方法および製造装置

【技術分野】

【0001】

本発明は、薄膜半導体の製造方法および製造装置に関するものである。特に、レーザ照射を用いて再結晶化を行なう技術に関するものである。

【背景技術】

【0002】

絶縁基板の表面に多結晶シリコン膜を半導体層として形成し、この半導体層を従来の半導体基板の代わりとして利用するような多結晶シリコン薄膜トランジスタが知られている。このような多結晶シリコン薄膜トランジスタにおいては、シリコンの結晶粒界がキャリアの移動度を制限するため、なるべく大粒径の多結晶シリコンを均一に形成することが望ましい。しかしながら、出発物質となるアモルファスシリコンにレーザを照射することで加熱して熔融させ、冷却の際に再結晶化を行なうという、いわゆるレーザ再結晶化方式では、結晶成長を促すシリコン熔融部の温度制御が困難であった。そのため、大粒径結晶を均一に、かつ安定して形成することは困難であった。

【0003】

これに対して、第一に、特開2000-12484号公報（特許文献1）に開示された技術がある。特許文献1では、可視域に波長を有する第1のパルスレーザ光と、第1のパルスレーザ光をその第2高調波に波長変換することによって生じる紫外域に波長を有する第2のパルスレーザ光とを重畳した状態でアモルファスシリコンに照射し、アモルファスシリコン上で、時間的かつ空間的に第2のパルスレーザ光が第1のパルスレーザ光に包含されるようにして、第2のパルスレーザ光で熔融したシリコンからの熱量の散逸を抑制することで熔融部の温度制御を行ない、比較的大粒径の多結晶シリコン膜を形成している。

【0004】

第二に、特開2000-286195号公報（特許文献2）に開示された技術がある。特許文献2では、可視光レーザであるNd:YAG2 ω レーザビームを用い、幅方向にはほぼガウス形状の光強度分布を有する細線状にレーザビームを集光し、アモルファスシリコン上である一定以上のエネルギー密度勾配をもつレーザビームとして照射している。この技術では、アモルファスシリコンでの吸収係数が低い可視レーザ光を採用することによって膜厚方向の温度勾配を抑制するとともに、幅方向での温度勾配を意図的に形成して1次元の横方向成長を生じさせている。このことにより、大粒径結晶列をもつ多結晶シリコン膜を得ている。

【特許文献1】特開2000-12484号公報

【特許文献2】特開2000-286195号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

上述の特許文献1の例では、第1のパルスレーザ光による加熱が重畳して熔融シリコンの冷却時間を長くすることにより結晶成長時間も長くなり、結晶は大きくなる。しかしながらアモルファスシリコンを熔融する第2のパルスレーザ光は紫外光であり、熔融したシリコン膜中に膜厚方向の温度勾配が生じるため、結晶は膜厚方向に成長する。そのため、結晶の大きさは膜厚に制限されてしまうという問題点があった。

【0006】

上述の特許文献2の例では、可視光のレーザビーム（以下、「可視レーザ」という。）を用いているため、結晶は膜厚方向ではなく横方向に成長する。したがって、膜厚による制限は受けずに大粒径化を図ることができる。しかし、ビーム形状が幅方向にガウス形状の分布をもつため、ビームのガウス形状分布の両側の勾配部分で同時に横方向結晶成長が生じる。特許文献2の例でも一般的なレーザ再結晶化方式の場合と同様に、細線状レーザビームを幅方向に重ね合わせながら順次照射位置を移動させていくことで順次結晶化を行

ない、アモルファスシリコン全面を結晶化していくが、進行方向前側の勾配部分で一旦形成された結晶部分では良質の多結晶シリコンが形成されているため、可視光の吸収は非常に少なく、第1のパルスレーザ光を単に照射しただけでは再度溶融するほどの熱量を与えることができない。このため、ガウス形状分布の勾配部分の両側でそれぞれ形成された多結晶シリコン列がそれぞれ独立に存在し、列間の結晶粒界の性質が悪いため、結晶粒径が大きくなった割にはキャリア移動度が高くないという問題点があった。

【0007】

そこで、本発明では、膜厚による制限を受けず、なおかつ、安定して大きな結晶粒径の多結晶シリコン膜を形成することができるような薄膜半導体の製造方法および製造装置を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0008】

上記目的を達成するため、本発明に基づく薄膜半導体の製造方法は、可視光パルスレーザを被照射物の表面に線形状に集光して、この線形状の照射領域の幅方向に次のタイミングの照射領域を重ね合わせるようにして位置をずらしながら繰返し照射して上記被照射物の表面に多結晶シリコン膜を形成する多結晶化工程を含み、上記多結晶化工程は、上記可視光パルスレーザが第1の照射領域に照射されている間または照射される前に上記第1の照射領域に部分的に重なる第2の照射領域に紫外光パルスレーザを照射する。

【発明の効果】

【0009】

本発明によれば、第1、第2のパルスレーザ光の重ね合わせによって被照射物の表面が溶融するが、第2のパルスレーザ光を照射した部分はアモルファス化するので、スキューを行なうことによって、所望の領域にきわめて良好な多結晶シリコン膜を形成することができる。特に、被照射物の全面にわたって横方向に成長した結晶に同一の結晶成長方向をもたせることができる。しかも、横方向成長の末端部分が再度溶融されて、それを起点に次の横方向成長が進むので、結晶成長がほぼ連続的となり、結晶性を非常に良くすることができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0010】

図1～図5を参照して、本発明に基づく薄膜半導体の製造方法および製造装置がどのような場面で用いられるのかについて説明する。図1に示すように絶縁基板201の上面にCVD (Chemical Vapor Deposition) 法を用いて、シリコン酸化膜などにより下地膜202を形成する。下地膜202は、絶縁基板201中の不純物がこれから形成する多結晶シリコン膜中に拡散するのを防止するバリアの役割を担うものである。さらにその上を覆うようにアモルファスシリコン膜203を形成する。

【0011】

図2の矢印204に示すように、レーザ光として350nm以上の可視域の波長を有する第1のレーザ光および350nm未満の紫外域の波長を有する第2のレーザ光を照射する。このレーザ光照射は、アモルファスシリコン膜203を加熱し、溶融させる。こうして溶融したシリコンが冷却・固化する際に多結晶シリコン膜205が形成される。その後、フォトリソグラフィ技術を用いて、図3に示すように多結晶シリコン膜206をアイランド状にパターンニングする。

【0012】

図4に示すように、ゲート絶縁膜207としてシリコン酸化膜を形成し、さらにゲート電極208を形成する。図5に示すように、層間絶縁膜211としてシリコン酸化膜またはシリコン窒化膜を形成し、ソース電極209およびドレイン電極210を形成する。このようにして、多結晶シリコン膜206を半導体層とする薄膜トランジスタが作成される。

。

【0013】

本発明が主に注目するのは、このうち、図1から図2にかけての工程、すなわち、アモ

ルファスシリコン膜 203 にレーザー光を照射して一旦熔融させ、冷却・固化させることによって多結晶シリコン膜 205 を形成する工程である。以下、この工程について詳しく説明する。

【0014】

(実施の形態 1)

(薄膜半導体の製造装置の概要)

図 6 を参照して、本発明に基づく実施の形態 1 における薄膜半導体の製造装置であるレーザーアニール装置について説明する。このレーザーアニール装置は、パルスレーザー光源 1 を備える。パルスレーザー光源 1 は、可視域に属する波長を有する第 1 のパルスレーザー光 2 を発生させるためのものである。第 1 のパルスレーザー光 2 は、具体的には発振波長 515 nm のアルゴンパルスレーザー光である。被照射物 9 は図 1 に示したものであり、レーザー光が照射されることにより上面のアモルファスシリコン膜 203 が部分的に熔融し、再結晶化し、多結晶ポリシリコン膜を形成する。

【0015】

パルスレーザー光源 1 から被照射物 9 までの光路に沿っては、集光レンズ 11、非線形光学素子 10、ベンドミラー 12、ビーム調整光学系 13 および集光照射光学系 8 が、順に配列されている。非線形光学素子 10 は、第 1 のパルスレーザー光 2 の一部を波長変換して、紫外域に波長を有する第 2 のパルスレーザー光 6 を生成し、第 2 のパルスレーザー光 6 を第 1 のパルスレーザー光 2 と同軸上に重畳させて出射するためのものである。図 6 では表示の都合で非線形光学素子 10 より右側では第 1 のパルスレーザー光 2 と第 2 のパルスレーザー光 6 とが平行な 2 本の直線で表されているが、実際にはこれら 2 つのレーザー光は光軸が同一となっている。

【0016】

集光レンズ 11 は、非線形光学素子 10 に入射する第 1 のパルスレーザー光 2 の光強度を高め、非線形光学素子 10 における紫外光への波長変換効率の向上を図るためのものである。ベンドミラー 12 は、非線形光学素子 10 から出射した第 1 のパルスレーザー光 2 および第 2 のパルスレーザー光 6 の進行方向を直角に折り曲げるためのものである。集光照射光学系 8 は、第 1 のパルスレーザー光 2 および第 2 のパルスレーザー光 6 を集光して被照射物 9 に照射するための集光手段である。被照射物 9 は、被照射物移動手段としてのステージ 14 上に設置されている。ステージ 14 は、上下、左右に移動できるようになっている。

【0017】

非線形光学素子 10 を出射した第 1 のパルスレーザー光 2 および第 2 のパルスレーザー光 6 は、ベンドミラー 12 により直角に折り曲げられ、集光照射光学系 8 に入射する。これにより、第 1 のパルスレーザー光 2 および第 2 のパルスレーザー光 6 は、それぞれ線状に集光される。この製造装置では、第 2 のパルスレーザー光 6 の集光点が、被照射試料 9 上に位置するようにステージ 14 によって被照射物 9 の高さが調整されている。

【0018】

この製造装置におけるパルスレーザー光源 1 は、可視域にある発振波長 515 nm のアルゴンレーザーを用い、これを Q スイッチでパルス化することによって第 1 のパルスレーザー光 2 を発生させている。非線形光学素子 10 には、 β -BBO (β -BaB₂O₄、ベータバリウムボレイト) 結晶が用いられている。非線形光学素子 10 においては、波長 515 nm の光である第 1 のパルスレーザー光 2 を受光して第 1 のパルスレーザー光 2 の 2 倍高調波である第 2 のパルスレーザー光 6 を発生させる際に位相整合条件が満たされるように β -BBO 結晶の表面がカットされている。したがって、第 2 のパルスレーザー光 6 は、波長 258 nm の紫外光となる。また、図には示していないが非線形光学素子 10 には温度および設置角度に応じた調整手段が設けられている。

【0019】

この製造装置においては、パルスレーザー光源 1、集光照射光学系 8 などの組合せによって、可視光パルスレーザーを基板状の被照射物 9 の表面に線状に集光して、この長手状の照射領域の幅方向に次のタイミングの照射領域を重ね合わせるようにして位置をずらしなが

ら繰返し照射する可視光パルスレーザ照射手段を構成し、備えている。さらに、この製造装置は、パルスレーザ光源 1、非線形光学素子 10、集光照射光学系 8 などの組合せによって、可視光パルスレーザが第 1 の照射領域に照射されている間または照射される前に前記第 1 の照射領域に部分的に重なる第 2 の照射領域に紫外光パルスレーザを照射する紫外光パルスレーザ照射手段を構成し、備えている。

【0020】

(薄膜半導体の製造方法)

図 7～図 16 を参照して、本発明に基づく実施の形態 1 における薄膜半導体の製造方法について説明する。

【0021】

この製造方法は多結晶化工程を含む。多結晶化工程においては、可視光パルスレーザである第 1 のパルスレーザ光 2 を、集光照射光学系 8 によって、基板状の被照射物 9 の表面に線形状に集光し、この線形状の照射領域の幅方向に次のタイミングの照射領域を重ね合わせるようにして徐々に位置をずらしながら繰返し照射して被照射物 9 の表面に多結晶シリコン膜 205 (図 2 参照) を形成する。

【0022】

ただし、この製造方法では、第 1 のパルスレーザ光 2 だけでなく、第 2 のパルスレーザ光 6 も照射されている。そこで、これら 2 つのパルスレーザ光の進行について詳しく説明する。

【0023】

パルスレーザ光源 1 を出射した第 1 のパルスレーザ光 2 は、集光レンズ 11 により集光され、非線形光学素子 10 に入射する。非線形光学素子 10 は、上述したように 2 倍高調波発生時に位相整合条件が満たされるようにカットされているため、非線形光学素子 10 に入射した第 1 のパルスレーザ光 2 の一部は 2 倍高調波へと波長変換され、紫外域に波長を有する第 2 のパルスレーザ光 6 となる。第 2 のパルスレーザ光 6 は、第 1 のパルスレーザ光 2 の光路に沿って発生するため、ウォークオフによる進行方向のずれを無視すれば、第 2 のパルスレーザ光 6 は、第 1 のパルスレーザ光 2 の同軸上に発生するものとみなすことができる。

【0024】

非線形光学素子 10 を出射した第 1 のパルスレーザ光 2 および第 2 のパルスレーザ光 6 は、同一のベンドミラー 12 により直角に折り曲げられ、ビーム調整光学系 13 に入射する。ビーム調整光学系 13 は複数の円筒凸レンズおよび円筒凹レンズから構成されており、第 1 のパルスレーザ光 2 および第 2 のパルスレーザ光 6 のビーム径を拡大するとともに、ビーム広がり角を低減させる。

【0025】

非線形光学素子 10 から集光照射光学系 8 までは、可視光域に波長を有する第 1 のパルスレーザ光 2 と、紫外域に波長を有する第 2 のパルスレーザ光 6 とが同一の光軸上を進むように両者を伝送するレーザ伝送部である。

【0026】

集光照射光学系 8 に入射した第 1 のパルスレーザ光 2 および第 2 のパルスレーザ光 6 は、線形状に集光される。ここで、集光照射光学系 8 は、光軸に対して対称に設置された一対のプリズム 80 を備える。このため、第 1 のパルスレーザ光 2 と第 2 のパルスレーザ光 6 との波長の違いにより、出射角度が異なるようになっている。本実施の形態では、このような集光照射光学系 8 の機能を利用して、第 1 のパルスレーザ光 2 の集光点と第 2 のパルスレーザ光 6 の集光点とをずらし、第 2 のパルスレーザ光 6 の集光点が常に被照射物 9 の進行方向後ろ側になるように照射する。第 1 のパルスレーザ光 2 と第 2 のパルスレーザ光 6 とは、波長が異なるため色収差を生じ、集光点が異なる。この製造方法においては、紫外域に波長を有する第 2 のパルスレーザ光 6 の集光点が、被照射物 9 上に位置するようにステージ 14 によって被照射試料 9 の高さが調整されている。

【0027】

本実施の形態における製造方法によって被照射物 9 上に生じる第 1 のパルスレーザ光 2 と第 2 のパルスレーザ光 6 との各照射領域のパターンを図 7 に示す。第 2 のパルスレーザ光 6 の照射領域 3 6 が、第 1 のパルスレーザ光 2 の照射領域 3 5 に概ね半分重なっている。図 7 において、矢印 7 1 は被照射物 9 が進行する向きを示す。矢印 3 4 は、第 1 のパルスレーザ光 2 の照射領域 3 5 が被照射物 9 の表面を結果的にスキャンする向きを示す。第 2 のパルスレーザ光 6 の照射領域 3 6 は、被照射物 9 の進行方向後ろ側に位置するように集光されている。また、長手方向すなわち図 7 における左右方向に関しては、第 2 のパルスレーザ光 6 の照射領域 3 6 が第 1 のパルスレーザ光 2 の照射領域 3 5 と同じ長さとなっているか、あるいは好ましくは、より長くなっているのがよい。

【0028】

図 8 (a), (b) に、集光レンズ 2 1 から出射する第 1 のパルスレーザ光 2 2 がアモルファスシリコン膜 2 0 3 に照射されてアモルファスシリコン膜 2 0 3 が熔融する様子の概念図を示す。図 8 (a) における第 1 のパルスレーザ光 2 2 は、第 1 のパルスレーザ光 2 (図 6 参照) が集光照射光学系 8 内に備えられた集光レンズ 2 1 によって線形状に集光されたものである。

【0029】

線形状となった第 1 のパルスレーザ光 2 2 は、アモルファスシリコン膜 2 0 3 上の照射領域 3 5 に照射されるが、そのときの第 1 のパルスレーザ光 2 2 のエネルギー密度のプロファイル 2 4 を図 8 (a) に示す。プロファイル 2 4 は、図 8 (a) に示すように照射領域 3 5 の長手方向に関してはほぼ変化せず均一である、いわゆるトップフラット状であり、照射領域 3 5 の幅方向にはほぼガウス分布状である。

【0030】

このようなプロファイル 2 4 を有するアルゴンレーザによって熱処理を行なうと、アモルファスシリコンに対するアルゴンレーザの吸収係数が小さいために膜厚方向に対してはほぼ均一に加熱される。このレーザ照射によって生じるシリコン膜内の横方向温度分布は、線状ビームの幅方向にのみ形成される。このレーザ照射によって生じるシリコン膜内の横方向の温度勾配は、線形状の照射領域 3 5 の幅方向に関してのみ形成される。したがって、図 8 (b) に示すように、被照射物 9 の上面を覆うアモルファスシリコン膜 2 0 3 のうち、ある強度以上のビームが照射された領域が、深さ方向に関しては全体にわたって熔融する。すなわち、深さ方向では全体に広がった熔融部 2 6 が線形状の局所的領域に生じる。その様子を別の角度から表現したものを図 9 (a) ~ (c) に示す。図 9 (a) に示すプロファイル 2 4 のレーザ光が照射されることで、アモルファスシリコン膜 2 0 3 内は図 9 (c) に示す温度分布となり、温度が融点を越えた領域においてのみアモルファスシリコンが熔融し、図 9 (b) に示すように熔融部 2 6 となっている。

【0031】

深さ方向および線形状の照射領域 3 5 (図 8 (a) 参照) の長手方向には温度勾配が少ないため、結晶成長は照射領域 3 5 の幅方向への 1 次元横方向成長となり、図 10 (a), (b) に示すように結晶粒径が数 μm 程度という大きな結晶粒 2 9 が形成される。また、結晶成長の向きは照射領域 3 5 の幅方向であるので、このレーザ照射によって形成される多結晶シリコン膜の結晶粒 2 9 は、図 10 (a) に示すように照射領域の幅方向 3 0 に揃う。図 10 (b) は、こうして再結晶化された部分の断面図であるが、深さ方向には温度勾配がほとんどないため、膜厚方向に関しては全域が一様に結晶化している。

【0032】

以上のような波長 350 nm 以上のパルスレーザ光による熱処理における横方向の結晶成長の過程は、シリコン膜内での横方向に関する温度分布に大きく影響される。すなわち、照射される線形状のビームの幅方向のエネルギー密度分布に大きく影響される。レーザ光照射によりシリコン膜内に導入された熱は、一様に被照射物 9 の他の部分へと散逸していく。すなわち、シリコン膜内の横方向温度分布曲線は図 11 (b) に示すように一様に低下していく。したがって、図 11 (b) の矢印 3 2 に示すように、先に温度が融点を下回った部分から、後で温度が融点を下回る部分に向かって横方向に結晶成長が進む。こう

して、図 11 (a) に示すように横方向成長結晶 31 が形成される。

【0033】

この横方向への結晶成長は、温度が冷えていく過程で自然核発生により成長した微結晶により、その行く手を遮られたときに止まる。したがって、横方向成長結晶 31 として大きな粒径の結晶を成長させるためには、自然核発生が起こるまでの時間にできるだけ結晶粒が長く成長していることが好ましい。そのためには結晶成長速度が速いことが要求される。一般に、ある微小領域における結晶成長速度 v は $v = k \Delta T / \Delta x$ により表される。ここで、 k は速度定数、 ΔT は微小領域における温度差、 Δx は微小領域の幅である。すなわち、シリコン膜内の横方向に関して温度差が存在する場合、融点以上の温度である領域の温度分布が急峻な勾配であれば、結晶成長速度が速く、その結果、大きな結晶粒径の多結晶シリコン膜の形成が可能となる。このことを考慮すれば、シリコン膜内における横方向温度分布の急勾配化は、ターゲット表面における照射エネルギー密度分布を急勾配にすることにより実現できる。

【0034】

第 1 のパルスレーザー光 22 は、幅方向のプロファイルがガウス分布状になっているので、上述したアモルファスシリコン膜 203 表面における照射エネルギー密度分布の急勾配部分は幅方向の両側に合計 2 つ存在する。これら 2 つの部分でそれぞれ横方向成長する結晶は、幅方向の中心部分に向かって成長したものとなる。基板状の被照射物 9 の表面全体を多結晶シリコン膜 205 にするためには、被照射物 9 を図 8 (a) に示す矢印 71 に示す向きに移動させることで、第 1 のパルスレーザー光 22 が被照射物 9 の表面を相対的に矢印 34 の向きにスキャンすることとなる。しかし、このスキャンにおいては、被照射物 9 上の任意の 1 点に注目すれば、この 1 点に対しては、第 1 のパルスレーザー光 22 の照射領域 35 (図 8 (a) 参照) の被照射物 9 進行方向後ろ側および前側の合計 2 つの急勾配部分が順に通ることで、照射領域 35 のうち被照射物 9 の進行方向後ろ側の急勾配部分でできた結晶部分に再び被照射物 9 の進行方向前側の急勾配部分が照射され、結晶性が改変されることになる。しかも、350 nm 以上のレーザー光のシリコンにおける吸収率は、図 12 に示すように、アモルファスシリコンに比べ結晶シリコンの部分では非常に低くなる。

【0035】

したがって、直前の照射により形成されている結晶の質によって非常に複雑な温度プロファイルがシリコン膜中に形成されてしまい、均一な結晶が形成できなかった。

【0036】

ところで、紫外波長を有する第 2 のパルスレーザー光をシリコン膜に照射した場合、吸収係数はアモルファスシリコンと結晶シリコンで概ね同程度であり、またその絶対値も 350 nm 以上の可視波長の光に比べ非常に大きい。このため、照射されるシリコン膜の質によらず表面でエネルギーが吸収され、膜厚方向に大きな温度分布を生じるので、横方向成長は生じない。紫外波長を有する第 2 のパルスレーザー光の照射エネルギー密度と、照射後に形成される結晶状態との関係を図 13 に示す。このグラフに示す結晶状態はそれぞれ光学顕微鏡で観察したものである。今回の実験では概ね $600 \text{ mJ} / \text{cm}^2$ を超える照射エネルギー密度では、照射前のシリコン膜の状態によらず、アモルファスシリコンとなっているという結果が得られている。

【0037】

(薄膜半導体の製造装置の詳細)

本実施の形態における製造装置では、図 8 (a), (b) に示すように、第 1 のパルスレーザー光 2 を線形状に集光した第 1 のパルスレーザー光 22 と、第 2 のパルスレーザー光 6 を線形状に集光した第 2 のパルスレーザー光 23 とを被照射物 9 に対して照射する仕組みとなっている。ただし、この製造装置は、被照射物 9 に対して可視域に波長を持つ第 1 のパルスレーザー光 22 を照射すると同時に、被照射物 9 の進行方向後ろ側のプロファイル 24 が急勾配となる部分に、紫外域に波長をもつ第 2 のパルスレーザー光 6 を線形状に集光した第 2 のパルスレーザー光 23 をほぼ同時に照射できる構成となっている。図 8 (a

)において矢印71は被照射物9が実際に移動する向きを示し、矢印34は、第1のパルスレーザー光22および第2のパルスレーザー光23が被照射物9の表面において相対的にスキャンする向きを示す。

【0038】

なお、第2のパルスレーザー光23の照射エネルギー密度は結晶化エネルギーより高いエネルギーとなっている。本実施の形態では、パルスレーザー光源1のエネルギーのうち約40%を第2のパルスレーザーに変換するようにすれば、この条件を満たすことができる。

【0039】

なお、本実施の形態では、集光照射光学系8は、光軸に対して対称な形状に配置された1対のプリズム80を備える。この1対のプリズム80は、照射領域差別化手段である。この1対のプリズム80をスライドさせることにより、ガウス分布状の第1のパルスレーザー光22のプロファイル24のいずれの側の急勾配部分に対しても第2のパルスレーザー光23が照射できるように構成されている。たとえば、基板である被照射物9全面を覆うように多結晶シリコン膜205を形成したい場合は、図14に示すように被照射物9表面をジグザグ状にスキャンして全面照射を行なえばよいが、この場合、1ラインをスキャンする度にスキャンの向きが反転する。スキャンの向きを反転させるとき、プリズム80をスライドさせて切り換えることにより第1のパルスレーザー光22の光軸に対して第2のパルスレーザー光23の光軸のずれる向きを変更することができる。このような構成によって、第2のパルスレーザー光は、常に、第1のパルスレーザーのプロファイル24の被照射物9の進行方向後ろ側の急勾配部分に照射されるようにすることができる。

【0040】

言い換えれば、本実施の形態における薄膜半導体の製造装置は、基板である被照射物9の表面に多結晶シリコン膜を形成するために、可視光パルスレーザーである第1のパルスレーザー光2を被照射物9の表面に線形状に集光して第1のパルスレーザー光22とし、この第1のパルスレーザー光22の線形状の照射領域35の幅方向に次のタイミングの照射領域を重ね合わせるようにして位置をずらしながら繰返し照射する可視光パルスレーザー照射手段と、前記可視光パルスレーザーが第1の照射領域35に照射されている間に前記第1の照射領域に部分的に重なる第2の照射領域36に紫外光パルスレーザーである第2のパルスレーザー光23を照射する紫外光パルスレーザー照射手段とを備える。

【0041】

(作用・効果)

図8(a)におけるプロファイル24, 25を拡大したところを図15(a)に示す。このようにプロファイル24, 25が重なるようにして照射されることによって、図15(b)に示すように、プロファイル24単独の場合(図9(a)~(c)参照)に比べて広い範囲で熔融し、熔融部26が形成される。このようなプロファイル24, 25の重ね合わせでスキャンすることによって、図16(a), (b)に示すように、被照射物9の進行方向後ろ側(図16(a), (b)における右側)の急勾配部分での結晶化は起こらず、第2のパルスレーザー光を照射した部分はアモルファス化することがわかった。さらに被照射物9に対するスキャンが進行するにつれて、アモルファス化した部分に第1のパルスレーザー光22の被照射物9の進行方向前側の急勾配部分が照射され、非常に均一な横方向成長結晶31が形成された。こうしてスキャンを行なうことによって、所望の領域にきわめて良好な多結晶シリコン膜205(図2参照)を形成することができた。

【0042】

さらに本実施の形態では、被照射物9の全面にわたって横方向に成長した結晶に同一の結晶成長方向をもたせることができる(図10(a), (b)参照)。一般に、結晶は成長するにしたがって結晶性が良くなる。本実施の形態では、横方向成長の末端部分に連なるアモルファス化した部分のシリコンが再度熔融されて、それを起点に次の横方向成長が進むので、結晶成長がほぼ連続的となり、結晶性が非常に良くなっていた。また、本実施の形態では、個々の結晶粒29の末端部で形成される結晶粒界の隆起も低減されることがわかった。

【0043】

このような薄膜半導体の製造装置を構成し、使用することによって、あるいは、このような薄膜半導体の製造方法を用いることによって、被照射物 9 の表面のアモルファスシリコン膜 203 を多結晶シリコン化することができ、しかも、得られる多結晶シリコン膜の結晶性を非常に良くすることができる。

【0044】

(実施の形態 2)

図 17 を参照して、本発明に基づく実施の形態 2 における薄膜半導体の製造装置であるレーザアニール装置について説明する。図 17 は、この薄膜半導体の製造装置においてパルスレーザ光源 1 として用いられる内部波長変換型固体レーザ装置 101 の概念図である。本実施の形態における薄膜半導体の製造装置では、内部波長変換型固体レーザ装置 101 が、パルスレーザ光源 1 として備わっているという点以外では、実施の形態 1 におけるもの（図 6 参照）と同様である。実施の形態 1 と重複する部分の説明は繰返さない。

【0045】

図 17 に示すように、内部波長変換型固体レーザ装置 101 は、活性媒質として用いられる固体素子である固体レーザ媒質 115 を備えている。固体レーザ媒質 115 としては、本実施の形態では、ネオジウムイオンがドープされた YAG（イットリウムアルミニウムガーネット）結晶が用いられている。固体レーザ媒質 115 の側方には固体レーザ媒質 115 を励起するための半導体レーザ素子 116 が配置されている。半導体レーザ素子 116 によって励起された固体レーザ媒質 115 は、波長 1064 nm の近赤外域にある基本波レーザ光 117 を放出する。基本波レーザ光 117 の光路上には、基本波レーザ光 117 をパルス化するための Q スイッチ 118 が設けられている。固体媒質レーザ 115 および Q スイッチ 118 を間に挟むような位置関係で、第 1 の端部ミラー 120 と第 2 高調波取出しミラー 122 とが設けられている。第 2 高調波取出しミラー 122 による反射光が向かう先には第 2 の端部ミラー 121 が設けられている。第 2 高調波取出しミラー 122 と第 2 の端部ミラー 121 との間には、基本波レーザ光 117 を波長変換し、第 2 高調波を発生する第 2 高調波発生用非線形光学素子 119 が設けられている。この第 2 高調波発生用非線形光学素子 119 には、本実施の形態においては KTP（ KTiOPO_4 、リン酸チタン酸カリウム）結晶が用いられている。第 2 高調波発生用非線形光学素子 119 は、波長 1064 nm の光を入射した際、2 倍高調波発生時に位相整合条件が満たされるよう表面がカットされている。したがって、第 2 高調波は、波長 532 nm の可視光となる。また、図には示していないが第 2 高調波発生用非線形光学素子 119 には温度および設置角度の調整手段が設けられている。

【0046】

この内部波長変換型固体レーザ装置 101 の内部では、第 1 の端部ミラー 120 を一端とし、第 2 の端部ミラー 121 を他端とした共振器が構成されており、その共振器の光路上には Q スイッチ 118、固体媒質レーザ 115、第 2 高調波取出しミラー 122 が配置されている。第 2 高調波発生用非線形光学素子 119 もまた、この共振器の内部の光路上に設けられており、共振器内部波長変換手段を構成している。第 1 の端部ミラー 120 には、波長 1064 nm の基本波レーザ光 117 に対し全反射を起こさせる全反射コーティングが施されている。第 2 の端部ミラー 121 には、波長 1064 nm の基本波レーザ光 117 と波長 532 nm の第 2 高調波との両者に対し全反射を起こさせる全反射コーティングが施されている。第 2 高調波取出しミラー 122 においては、光軸を折り曲げ、なおかつ第 2 高調波を共振器外部に取り出すために、波長 1064 nm の基本波レーザ光 117 に対しては全反射し、波長 532 nm の第 2 高調波に対しては全透過となるように 2 波長コーティングが施されている。第 2 高調波取出しミラー 122 を挟んで、第 2 高調波発生用非線形光学素子 119 と反対側には、第 2 高調波取出しミラー 122 から取り出された第 2 高調波の進行方向を折り曲げるための折曲げミラー 123 が設けられている。内部波長変換型固体レーザ 101 のケース 124 には、第 2 高調波光を取り出すためのビーム取出し窓 125 が設けられている。Q スイッチ 118 では、共振器内の光損失量を変化させ

ることができる。

【0047】

(動作)

次に動作を説明する。まず、半導体レーザ116から出射する励起光を固体レーザ媒質115の光軸側方から固体レーザ媒質115に照射して固体レーザ媒質115を励起する。励起された固体レーザ媒質115中では、励起光の波長、活性媒質の原子構造に応じた特定のエネルギー準位間で反転分布が生じる。反転分布は自然放出および誘導放出により減少するが、共振器内に配置したQスイッチ118による光損失が大きい状態では、共振器内の光強度は増大し得ず、誘導放出による反転分布の減少は無視することができる。したがって、励起による反転分布増加量が自然放出による反転分布減少量を上回る限り反転分布は増加し、高いエネルギーが固体レーザ媒質115内に蓄積される。固体レーザ媒質115内に高いエネルギーが蓄積された状態で、Qスイッチ118による光損失量を急速に低下させると、固体レーザ媒質115内で発生した自然放出光は、第1の端部ミラー120と第2の端部ミラー121とにより共振器内に閉じ込められる。さらに、固体レーザ媒質115の誘導放出による増幅作用を被り、共振器内の基本波レーザ光117の光強度は急速に増加する。誘導放出の発生割合は、固体レーザ媒質115を通過する光強度に比例するため、光強度の高い基本波レーザ光117が固体レーザ媒質115中を通過する際には誘導放出が顕著となり、反転分布はしきい値以下にまで減少してしまう。この結果、共振器内の基本波レーザ光117は発振を停止する。上述のように、共振器内にQスイッチ118を設置し、共振器内の光損失を増減することにより、ピーク光強度の高いパルス光を発生することができる。特に本実施の形態においては、基本波レーザ光117を第1の端部ミラー120および第2の端部ミラー121から構成される共振器内に閉じ込める構成としているので、共振器内の基本波レーザ光117の光強度は非常に高くなる。

【0048】

(作用・効果)

本実施の形態では、共振器内に第2高調波発生用非線形光学素子119を配置し、かつ第1の端部ミラー120と第2の端部ミラー121によって基本波レーザ光117を共振器内に閉じ込めているので、非常にピーク光強度の高い基本波レーザ光117を第2高調波発生用非線形光学素子119へと入射させることができる。第2高調波発生用非線形光学素子119において、基本波レーザ光117が第2高調波へ変換される割合は、理論的には基本波レーザ光117の光強度の2乗に比例する。この実施の形態に示すような波長変換手段を共振器の光路内に有する共振器内部波長変換構成によれば、高強度の基本波レーザ光117を第2高調波発生用非線形光学素子119に入射させ、効率良く第2高調波光を発生させることができる。

【0049】

共振器内で発生した第2高調波は、共振器内に設置した第2高調波取出しミラー122から共振器外部に取り出される。共振器を出射した第2高調波は、折曲げミラー123により進行方向を折り曲げられ、ビーム取出し窓125よりケース124の外部に出射する。ケース124の外部に出射した可視域に波長を有する第2高調波は、この発明に係る薄膜半導体の製造装置であるレーザアニール装置の第1のパルスレーザ光2としてアニーリングに使用される。

【0050】

なお、第2のパルスレーザ光6の発生方法、被照射物9までの伝送方法、被照射物9に対する照射方法は、非線形光学素子10が、波長532nmの光を入射した際の2倍高調波発生時に位相整合条件が満たされるようにカットされていることを除き、実施の形態1で示した構成と同じである。

【0051】

本実施の形態においては、固体レーザ媒質115を用いて近赤外域にある基本波レーザ光117を発生させ、Qスイッチ118でパルス化した基本波レーザ光117に対して、第2高調波発生用非線形光学素子119によって波長変換を施し、可視域に波長を有する

第2高調波を発生させ、第1のパルスレーザ光2としてアニーリングに使用している。このように、固体レーザ媒質から発生する基本波レーザ光を可視光に波長変換し、第1のパルスレーザ光としてアニーリングに使用すれば、実施の形態1と同様な効果が得られるばかりでなく、実施の形態1において第1のパルスレーザ光2の光源として用いていたアルゴンレーザなどのガスレーザとは異なり、第1のパルスレーザ光発生用の光源を小型化することができる。また、ガスレーザに比べて効率良く第1のパルスレーザ光2を発生させることができるので、アニーリング時のランニングコストが低減し、安価に高品質なアニーリングを行なうことができる。

【0052】

さらに、実施の形態1で示したアルゴンレーザは、放電中の電子によりガス媒質を励起するので、放電発生用の電極の消耗を避けることができず、寿命および長期信頼性の観点において十分優れているとはいえない。しかし、本実施の形態に示すように、固体レーザ媒質15を使用すれば、長期信頼性が格段に向上するばかりでなく、出力の安定性も向上するので、メンテナンスコストの低減を図ることが可能ばかりでなく、長期間にわたり品質の安定したアニーリングを行なうことができる。また、ガスレーザに比べて高出力化が容易であるため、アニーリング作業の生産性の向上を図ることが容易である。

【0053】

本実施の形態においては、固体レーザ媒質115にYAG結晶を使用した例を示したが、固体レーザ媒質115の材料はこれに限るものではなく、たとえばネオジウムイオンをドープしたYLF (LiYF₄) 結晶を使用すれば、波長1047nmあるいは1052nmの近赤外域にある基本波レーザ光117が得られる。さらに、自然放出の寿命がYAG結晶よりも長いので、Qスイッチ118で基本波レーザ光117をパルス化する際、固体レーザ媒質115内に効率良くエネルギーを蓄積することができる。また、固体レーザ媒質115の温度変化にともなう屈折率の変化がYAG結晶よりも小さいので、レーザ出力およびビーム品質の安定性が向上する。固体レーザ媒質115は、ここで言及したYAG結晶、YLF結晶に限らず、近赤外域に発振波長を有するものであればいずれも適用が可能であり、アニーリングに必要な条件に応じて最良の結晶を選定すればよい。

【0054】

また、この実施の形態においては、共振器内部で波長変換を行ない、固体レーザ媒質の第2高調波を発生する構成を示したが、共振器外に基本波レーザ光117を取り出しても基本波レーザ光117の光強度が十分に高く維持できるのであれば、第2高調波発生用非線形光学素子119を共振器外部に設置し、共振器外部で波長変換を行ない第2高調波を発生させ、第1のパルスレーザ光2としてアニーリングに使用してもよい。共振器外部に第2高調波発生用非線形光学素子119を配置すれば、共振器のアライメントが容易になるばかりでなく、出力の安定性はさらに向上し、アニーリング結果物の品質保持がさらに簡単になる。

【0055】

また、本実施の形態においては、半導体レーザ素子116を固体レーザ媒質115の励起光源として使用する構成を示したが、アークランプを固体レーザ媒質115の励起光源として使用してもよい。アークランプを励起光源として使用した場合、長期信頼性の観点で半導体レーザ116に比べ劣るものの、半導体レーザ116に比べ安価であるため、レーザアニール装置の製造コストの低減を図ることができる。

【0056】

本実施の形態においては、固体レーザ媒質115の第2高調波を第1のパルスレーザ光2として使用し、第1のパルスレーザ光2の2倍高調波を発生させ紫外域に波長を有する第2のパルスレーザ光6を発生させる構成を示したが、紫外域に波長を有する第2のパルスレーザ光6の発生手段は、2倍高調波発生に限るものではない。たとえば、固体レーザ媒質115の第2高調波を第1のパルスレーザ光2として使用する場合には、固体レーザ媒質115の基本波レーザ光117と第1のパルスレーザ光2である第2高調波を、非線形光学素子10に同時に入射させ和周波混合を行ない、紫外域に波長を有する基本波レー

ザ光の3倍高調波を第2のパルスレーザ光6として使用してもよい。波長変換を行なう非線形光学素子に対する熱負荷は、発生する波長変換光の波長が短くなるほど高くなるので、基本波レーザ光117の3倍高調波を第2のパルスレーザ光6として使用すれば、基本波レーザ光117の第2高調波の2倍高調波、すなわち、基本波レーザ光117の4倍高調波を第2のパルスレーザ光6として使用する場合よりも、第2のパルスレーザ光6を発生する非線形光学素子10の熱負荷が低減し、レーザアニール装置としての信頼性が向上する。

【0057】

実施の形態1および実施の形態2においては、Qスイッチを用いてレーザ光をパルス化する構成を示したが、パルス化の方法はこれに限るものではなく、例えばレーザ光源の励起をパルス動作で行なっても、アニーリングに適用可能なパルスレーザ光を得ることができる。

【0058】

(実施の形態3)

(構成)

図18を参照して、本発明に基づく実施の形態3における薄膜半導体の製造装置であるレーザアニール装置について説明する。この薄膜半導体の製造装置では、紫外域に波長を有する第2のパルスレーザ光を得る方法として、第1のパルスレーザ光2を発生させるパルスレーザ光源1から高調波を取り出すのではなく、パルスレーザ光源1とは別の独立したパルスレーザ光源51を備えている。パルスレーザ光源51は、紫外レーザ光源であり、波長308nmのXeClエキシマレーザである。パルスレーザ光源51から出射した第2のパルスレーザ光6を第1のパルスレーザ光2に対して同軸に重ね合わせるためにパルスレーザ光源1と集光照射光学系8の間にダイクロイックミラー52を設置し、第1のパルスレーザ光2はほとんどロス無く透過させ、かつ第2のパルスレーザ光6を効率良く反射させて第1のパルスレーザ光2の光軸と第2のパルスレーザ光6の光軸とを一致させている。また、これら2つのレーザ光源の発振タイミングはタイミングコントローラにより同期させ、概ね同タイミングで被照射物9に照射されるようにしている。

【0059】

(作用・効果)

本実施の形態のように第1、第2のパルスレーザの光源が別々に存在していても、実施の形態1と同様の照射を行ない、同様の効果を得ることができる。

【0060】

本実施の形態では、第2のパルスレーザ光6を第1のパルスレーザ光2に依存せずに発生させることが可能であるので、第1のパルスレーザ光2から第2のパルスレーザ光6に波長変換するための非線形光学素子が不要となる。したがって、レーザアニール装置としての信頼性が向上する。

【0061】

なお、本実施の形態では、紫外域に波長を有する第2のパルスレーザ光としてXeClを用いたが、レーザの種類はこれに限られず、350nm未満に発振波長を有するパルスレーザであれば、同様の効果を奏する。

【0062】

(実施の形態4)

(構成)

図19を参照して、本発明に基づく実施の形態4における薄膜半導体の製造装置について説明する。実施の形態3における薄膜半導体の製造装置では、第1のパルスレーザ光2と第2のパルスレーザ光6とをダイクロイックミラー52で同じ光軸に合わせたが、実施の形態4では、ダイクロイックミラー52から出射するそれぞれの光軸の向きにわずかに差をつけている。この角度の差は、被照射物9の表面で第2のパルスレーザ光の照射領域が、第1のパルスレーザ光の照射領域に概ね半分重なり、被照射物9の進行方向後ろ側に位置するような設定となっている。

【0063】

本実施の形態では、ダイクロイックミラー 52 が照射領域差別化手段である。

【0064】

(作用・効果)

この場合も実施の形態 1, 3 と同様の照射を行なうことができる。本実施の形態によってもこれまでの実施の形態と同様の効果を得ることができる。また、本実施の形態では、集光照射光学系 8 のプリズム 80 が不要となるので、薄膜半導体の製造装置を安価に実現できる。

【0065】

(実施の形態 5)

図 20 (a) ~ (i) を参照して、本発明に基づく実施の形態 5 における薄膜半導体の製造装置について説明する。実施の形態 1 ~ 4 における薄膜半導体の製造装置では、第 1 のパルスレーザ光と第 2 のパルスレーザ光とをそれぞれ線形状に集光した状態で概ね同時に被照射物 9 に向けて照射したが、本発明の要点は、第 1 のパルスレーザ光のプロファイルのうち被照射物の進行方向後ろ側の急勾配の部分で形成される横方向成長の結晶部分をアモルファス化することにある。したがって、第 1, 第 2 のパルスレーザ光を必ずしも同時に照射する必要はなく、被照射物の進行方向後ろ側の急勾配の部分で横方向成長結晶が形成された後、被照射物の進行方向前側の急勾配の部分で照射されるまでの間に、第 2 のパルスレーザ光でこの横方向成長結晶部分をアモルファス化しても同様の効果が得られる。

【0066】

エネルギー密度のプロファイルとして図 20 (a) に示すプロファイル 24 を有する第 1 のパルスレーザ光を照射する。被照射物 9 は矢印 71 の向きに移動し、その結果、被照射物 9 に対する第 1 のパルスレーザ光によるスキュンは矢印 34 の向きに行なわれる。こうして、図 20 (b) に示すように、被照射物 9 表面のアモルファスシリコン膜 203 の中に熔融部 26 が生じる。次に冷却が始まり、図 20 (c) に示すプロファイル 24 の両側の勾配部分で横方向成長結晶 31 が形成される。次に、図 20 (d) に示すように、プロファイル 25 を有する第 2 のパルスレーザ光を照射する。このとき、第 2 のパルスレーザ光は、プロファイル 25 がプロファイル 24 のうち、被照射物 9 の進行方向後ろ側すなわち矢印 71 と反対側の勾配部分に重なるような位置に照射される。その結果、図 20 (e) に示すように、プロファイル 25 に覆われた領域で熔融部 26 が形成される。このとき、被照射物 9 の進行方向前側の横方向成長結晶 31 は残るが被照射物 9 の進行方向後ろ側の横方向成長結晶 31 は再び熔融部 26 となる。この状態の被照射物 9 が冷却することによって、熔融部 26 であった部分が図 20 (f) に示すようにアモルファス化し、アモルファス部分 37 となる。次に、図 20 (g) に示すようにプロファイル 24 n を有する第 1 のパルスレーザ光を照射する。プロファイル 24 n は第 1 のパルスレーザ光の前の照射時のプロファイル 24 に比べて図中右にずれた位置となっている。よって図 20 (h) に示すように、図中左側の横方向成長結晶 31 はそのまま残り、アモルファス部分 37 が再び熔融部 26 となる。このとき、プロファイル 24 n の勾配部分はプロファイル 24 で形成されていた勾配部分に比べ、図中右側にずれた位置にあるので、横方向成長結晶 31 の末端部分から図中右側に向けてさらに結晶が成長する。したがって、冷却後には図 20 (i) に示す横方向成長結晶 38 のように長く延びた良質の結晶が形成される。このとき、プロファイル 24 n の図中右側の勾配部分でも横方向成長結晶 31 が形成されるが、この部分はその後、再度プロファイル 25 (図 20 (d) 参照) を有する紫外域の第 2 のパルスレーザ光が照射されることによりアモルファス化する。このような手順で図 20 (a) ~ (i) のサイクルを繰返すことにより、被照射物 9 表面のスキュンが進行する。

【0067】

(作用・効果)

本実施の形態のように第 1, 第 2 のパルスレーザを同時でなく別々のタイミングで照射することによっても、これまでの実施の形態と同様の効果を得ることができる。

【0068】

特に実施の形態3のように、それぞれ独立のレーザ光源を用いた場合には、本実施の形態のように第1、第2のパルスレーザを別々のタイミングで照射することは好都合である。なぜなら、同時照射のための数ナノ秒のオーダーの同期が不要となるからである。本実施の形態では、せいぜい第1のパルスレーザの発振周期であるミリ秒オーダーの非常にラフな同期が実現できさえすれば足りるので、薄膜半導体の製造方法および製造装置の安定度が高まる。

【0069】

なお、今回開示した上記実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではない。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更を含むものである。

【図面の簡単な説明】

【0070】

【図1】本発明に基づく薄膜半導体の製造方法が用いられる半導体装置の製造方法の第1の工程の説明図である。

【図2】本発明に基づく薄膜半導体の製造方法が用いられる半導体装置の製造方法の第2の工程の説明図である。

【図3】本発明に基づく薄膜半導体の製造方法が用いられる半導体装置の製造方法の第3の工程の説明図である。

【図4】本発明に基づく薄膜半導体の製造方法が用いられる半導体装置の製造方法の第4の工程の説明図である。

【図5】本発明に基づく薄膜半導体の製造方法が用いられる半導体装置の製造方法の第5の工程の説明図である。

【図6】本発明に基づく実施の形態1における薄膜半導体の製造装置の概念図である。

【図7】本発明に基づく実施の形態1における製造方法によって被照射物上に生じる第1、第2のパルスレーザ光の照射領域の重なり具合の説明図である。

【図8】(a)、(b)は、本発明に基づく実施の形態1における薄膜半導体の製造方法に含まれるスキャン照射工程の説明図である。

【図9】(a)は、本発明に基づく実施の形態1における第1のパルスレーザ光を単独で照射した場合の幅方向のエネルギー密度分布のプロファイルのグラフである。(b)は、第1のパルスレーザ光によって被照射物の中に熔融部が生じる様子を示す断面図である。(c)は、被照射物内部の温度分布を示すグラフである。

【図10】(a)、(b)は、本発明に基づく実施の形態1における薄膜半導体の製造方法に含まれるスキャン照射工程によって成長した結晶粒の説明図である。

【図11】(a)、(b)は、本発明に基づく実施の形態1における薄膜半導体の製造方法に含まれるスキャン照射工程によって横方向に結晶が成長していく様子の説明図である。

【図12】波長と吸収係数との関係を示すグラフである。

【図13】第2のパルスレーザ光の照射エネルギー密度と、照射後に形成される結晶状態との関係を示すグラフである。

【図14】本発明に基づく実施の形態1における薄膜半導体の製造方法に含まれる多結晶化工程で被照射物の表面をジグザグ状にスキャンする様子の説明図である。

【図15】(a)は、本発明に基づく実施の形態1における第1、第2のパルスレーザ光の幅方向のエネルギー密度分布のプロファイルのグラフである。(b)は、第1、第2のパルスレーザ光同士の重ね合わせによって被照射物の中に熔融部が生じる様子を示す断面図である。(c)は、被照射物内部の温度分布を示すグラフである。

【図16】(a)、(b)は、本発明に基づく実施の形態1における薄膜半導体の製造方法に含まれる多結晶化工程によって横方向に結晶が成長していく様子の説明図である。

【図 17】本発明に基づく実施の形態 2 における薄膜半導体の製造装置に含まれる内部波長変換型固体レーザー装置の概念図である。

【図 18】本発明に基づく実施の形態 3 における薄膜半導体の製造装置の概念図である。

【図 19】本発明に基づく実施の形態 4 における薄膜半導体の製造装置の概念図である。

【図 20】(a) ~ (i) は、本発明に基づく実施の形態 5 における薄膜半導体の製造方法に含まれる多結晶化工程の説明図である。

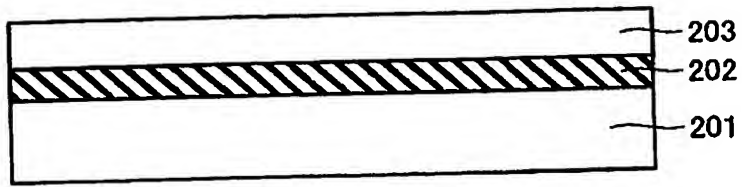
【符号の説明】

【0071】

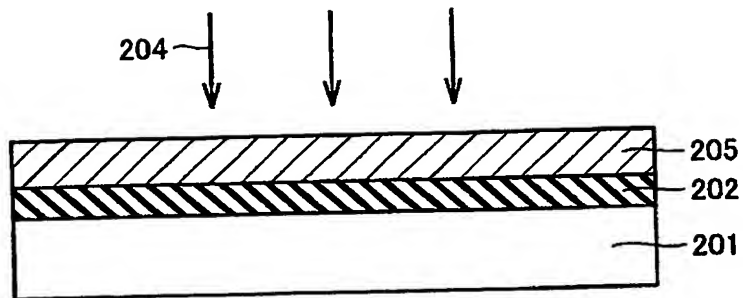
1 パルスレーザー光源、2 第 1 のパルスレーザー光、6 第 2 のパルスレーザー光、8 集光照射光学系、9 被照射物、10 非線形光学素子、11 集光レンズ、12 ベンドミラー、13 ビーム調整光学系、14 ステージ、21 (線形上に集光するための) 集光レンズ、22 (線形状に集光された) 第 1 のパルスレーザー光、23 (線形状に集光された) 第 2 のパルスレーザー光、24 (集光された第 1 のパルスレーザー光の) プロファイル、24n (新たに照射された第 1 のパルスレーザー光の) プロファイル、25 (集光された第 2 のパルスレーザー光の) プロファイル、26 熔融部、27 (線形状に集光されたビームの) 長手方向、29 結晶粒、31, 38 横方向成長結晶、32 (結晶が成長する向きを示す) 矢印、34 (第 1 のパルスレーザー光の照射領域が相対的にスキャンする向きを示す) 矢印、35 (第 1 のパルスレーザー光の) 照射領域、36 (第 2 のパルスレーザー光の) 照射領域、37 アモルファス部分、51 (第 2 のパルスレーザー光を発する) パルスレーザー光源、52 ダイクロイックミラー、53 (第 1 のパルスレーザー光の) 光軸、54 (第 2 のパルスレーザー光の) 光軸、71 (被照射物が移動する向きを示す) 矢印、80 プリズム、101 内部波長変換型固体レーザー装置、115 固体レーザー媒質、116 半導体レーザー素子、117 基本波レーザー光、118 Q スイッチ、119 第 2 高調波発生用非線形光学素子、120 第 1 の端部ミラー、121 第 2 の端部ミラー、122 第 2 高調波取出しミラー、123 折曲げミラー、124 ケース、125 ビーム取出し窓、201 絶縁基板、202 下地膜、203 アモルファスシリコン膜、204 (レーザー照射を表す) 矢印、206 (パターニングされた) 多結晶シリコン膜、207 ゲート絶縁膜、208 ゲート電極、209 ソース電極、210 ドレイン電極、211 層間絶縁膜。

【書類名】 図面

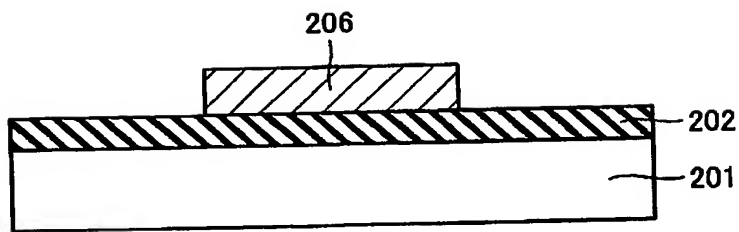
【図 1】



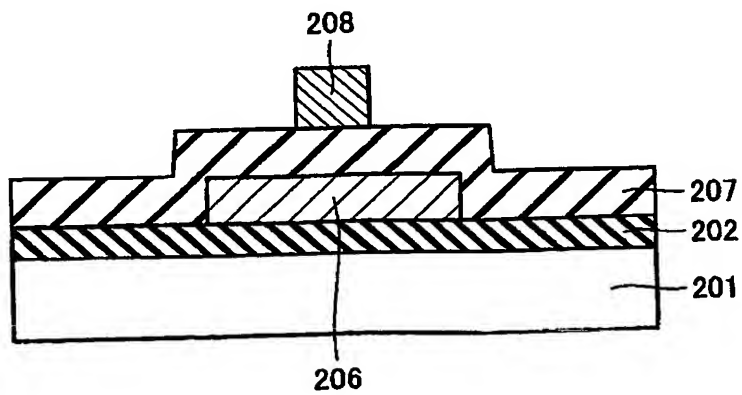
【図 2】



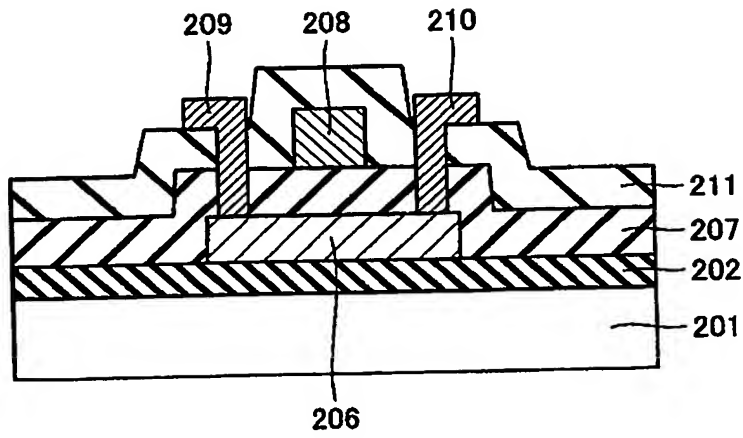
【図 3】



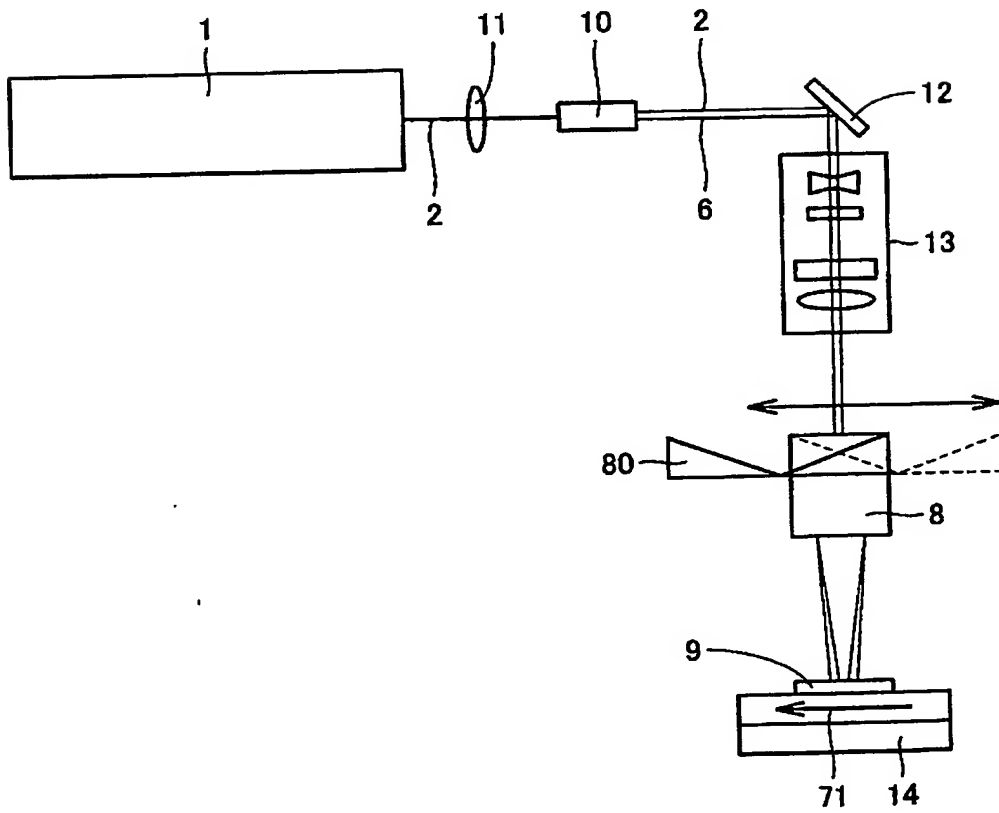
【図 4】



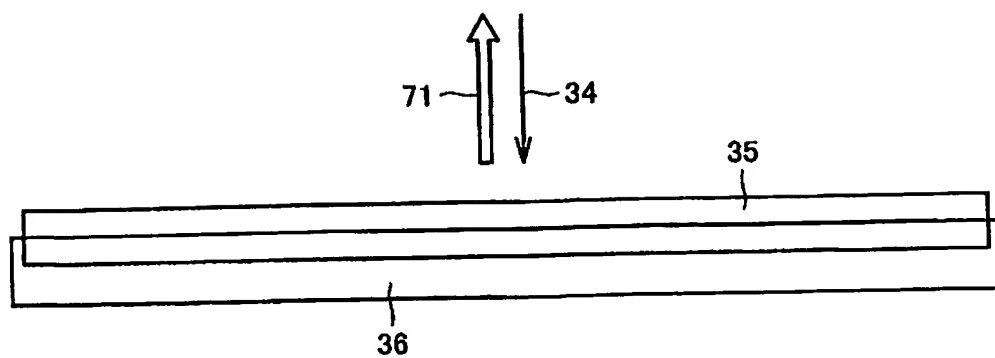
【図 5】



【図 6】

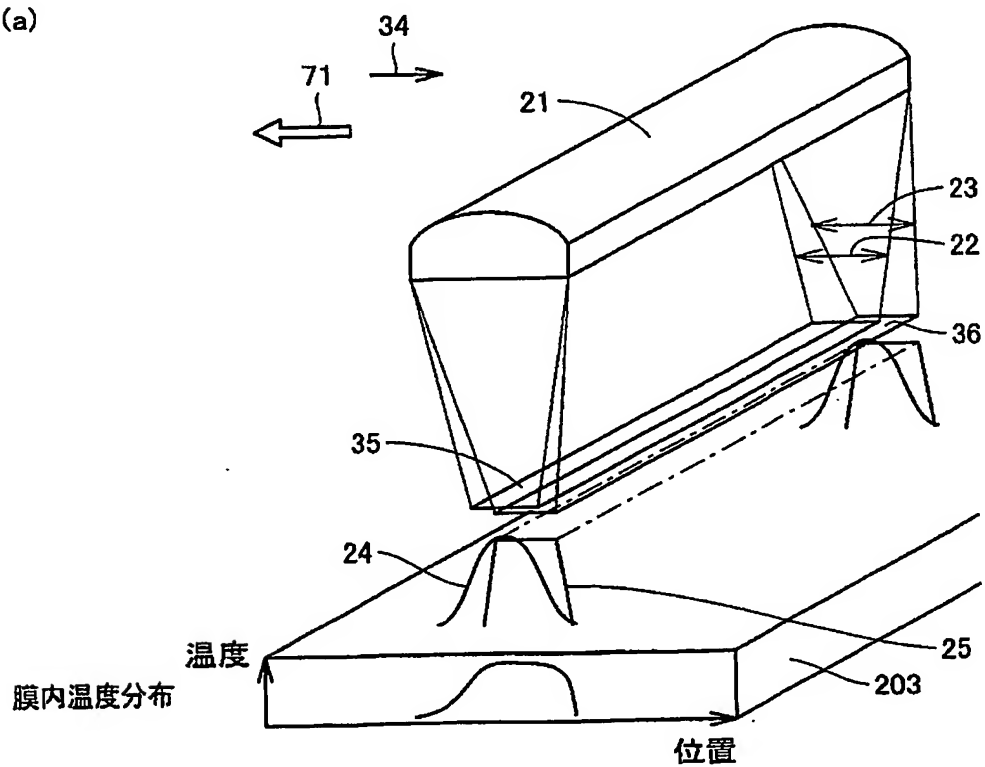


【図 7】

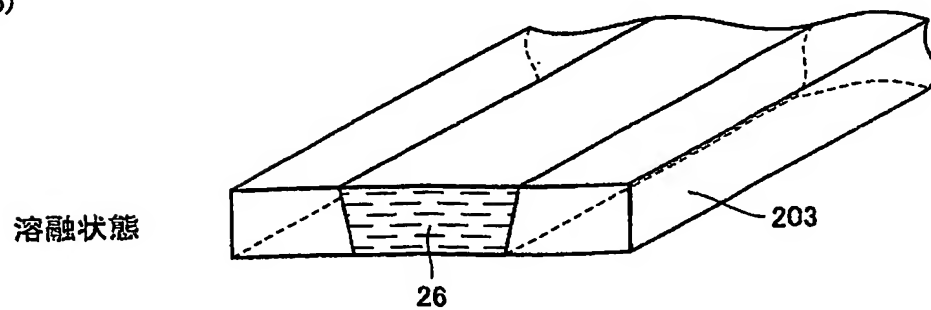


【図 8】

(a)

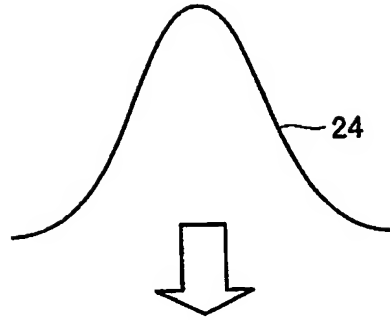


(b)



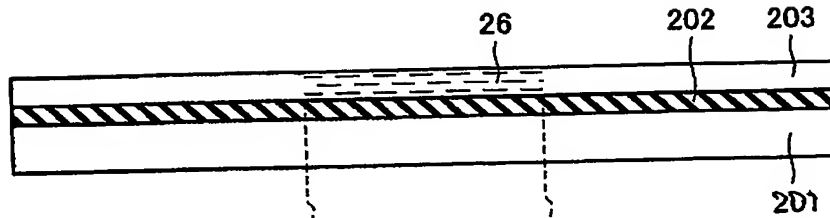
【図 9】

(a)

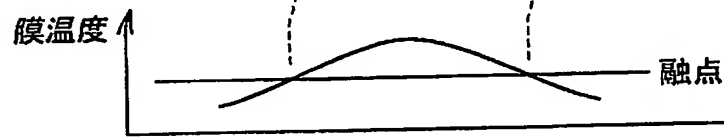


(b)

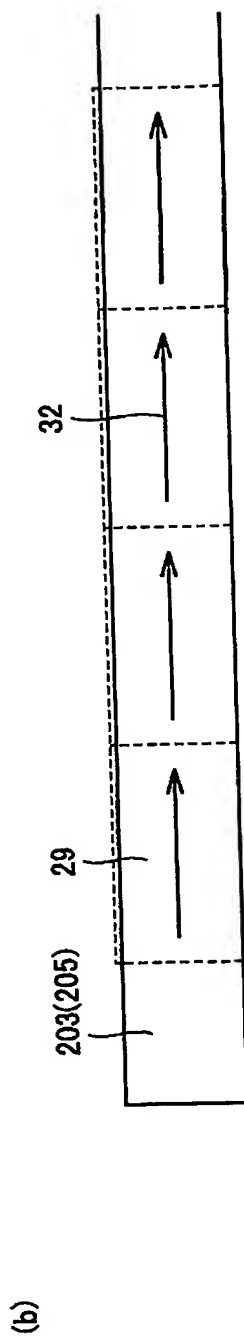
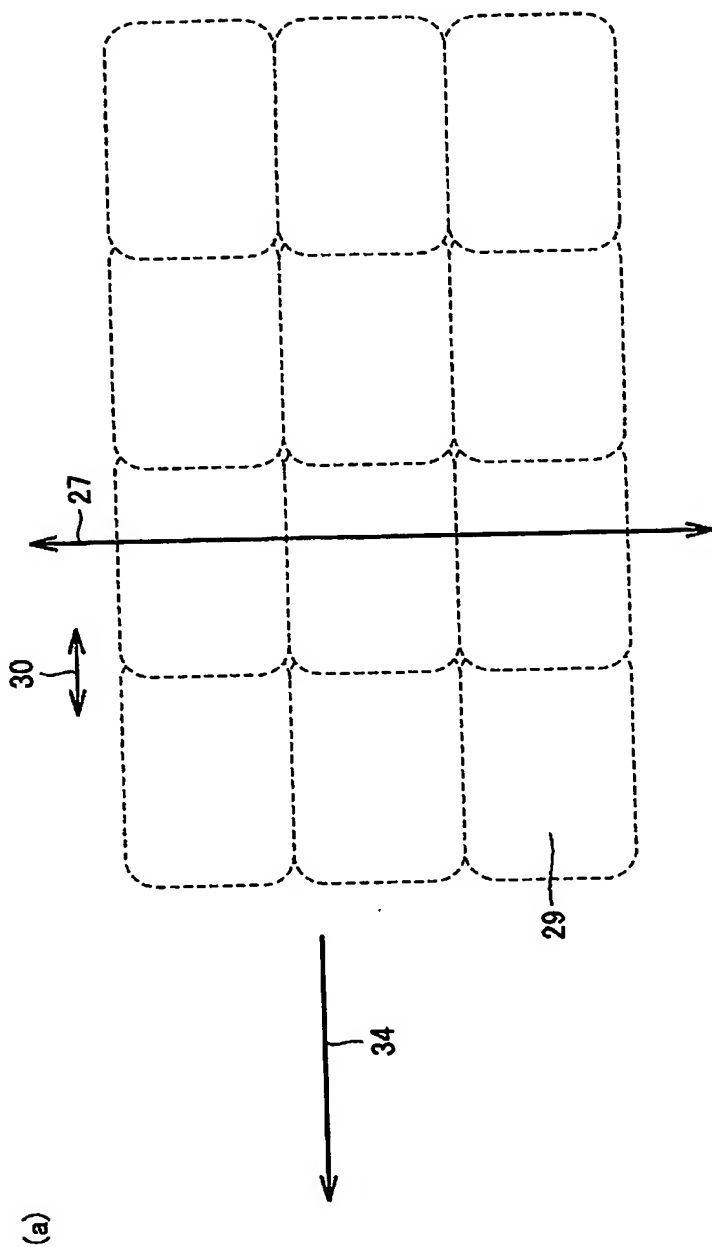
照射時



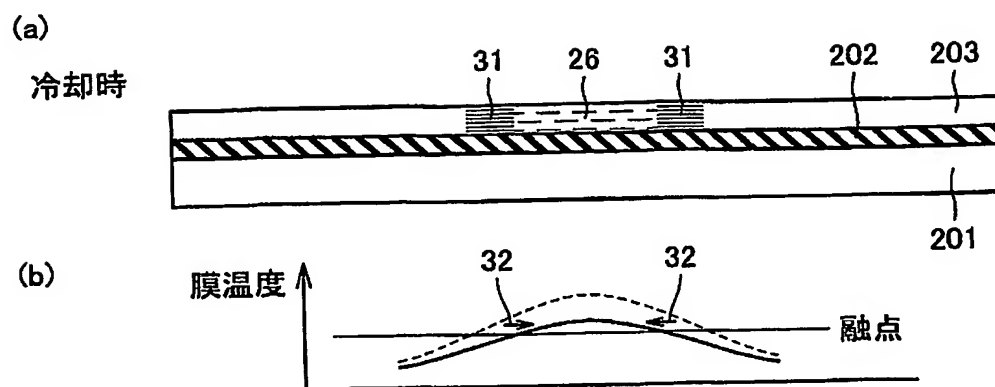
(c)



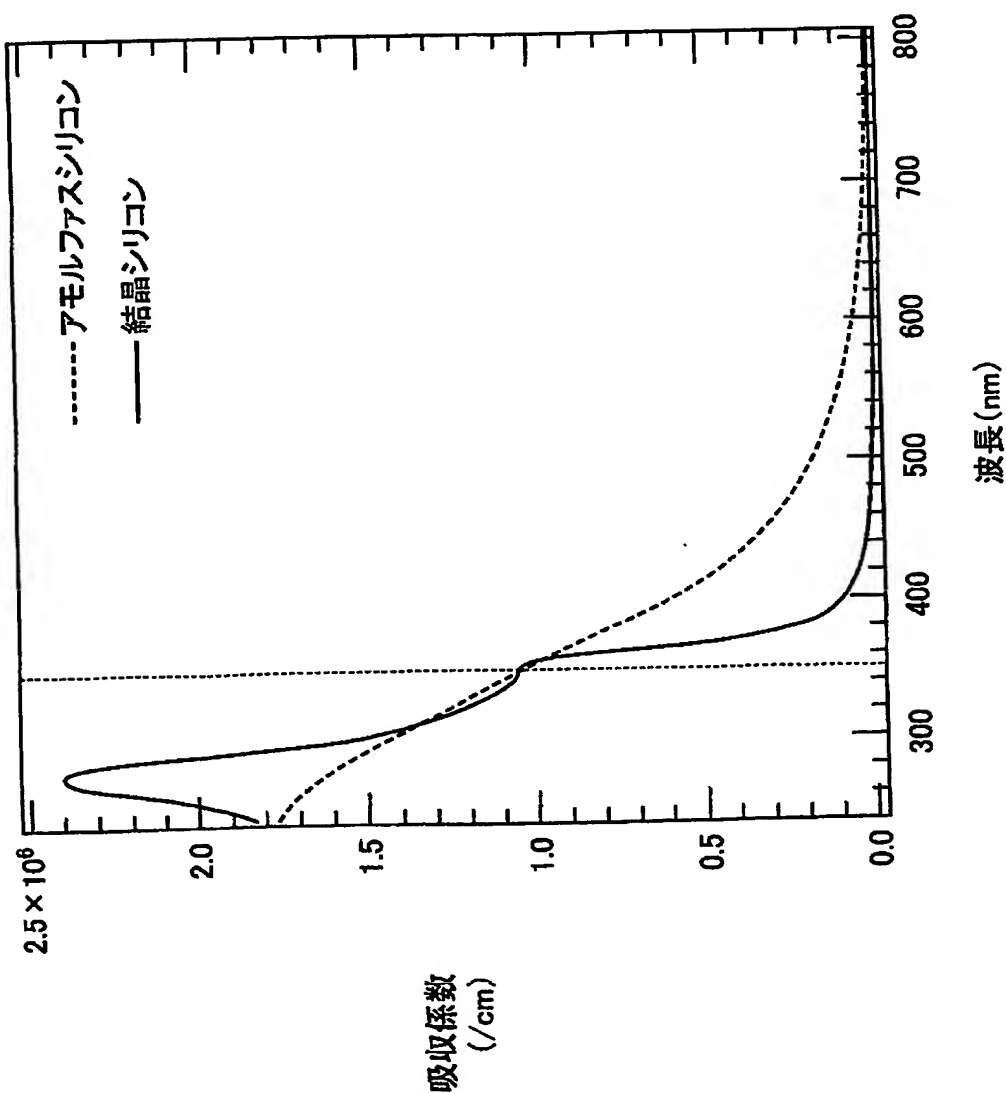
【図 10】



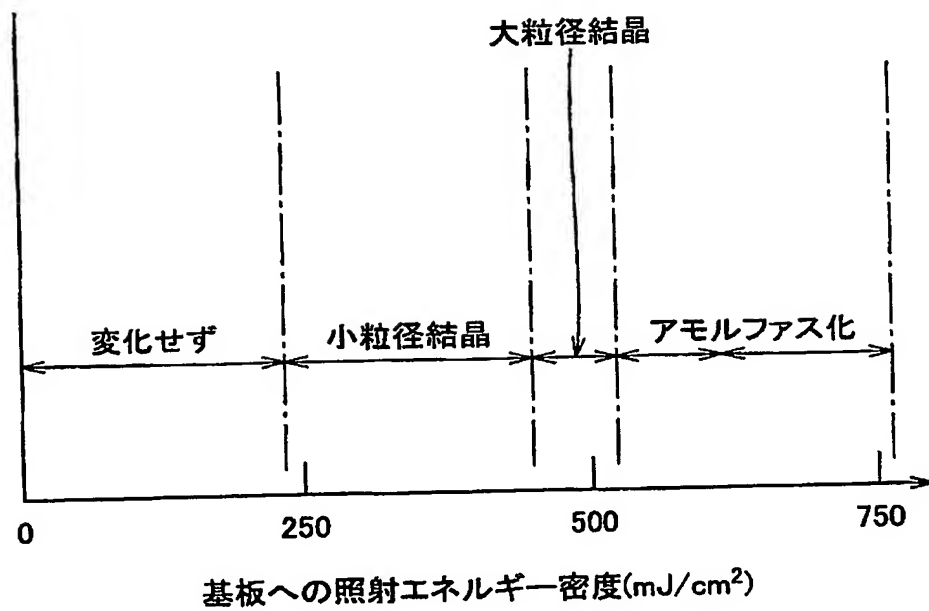
【図 11】



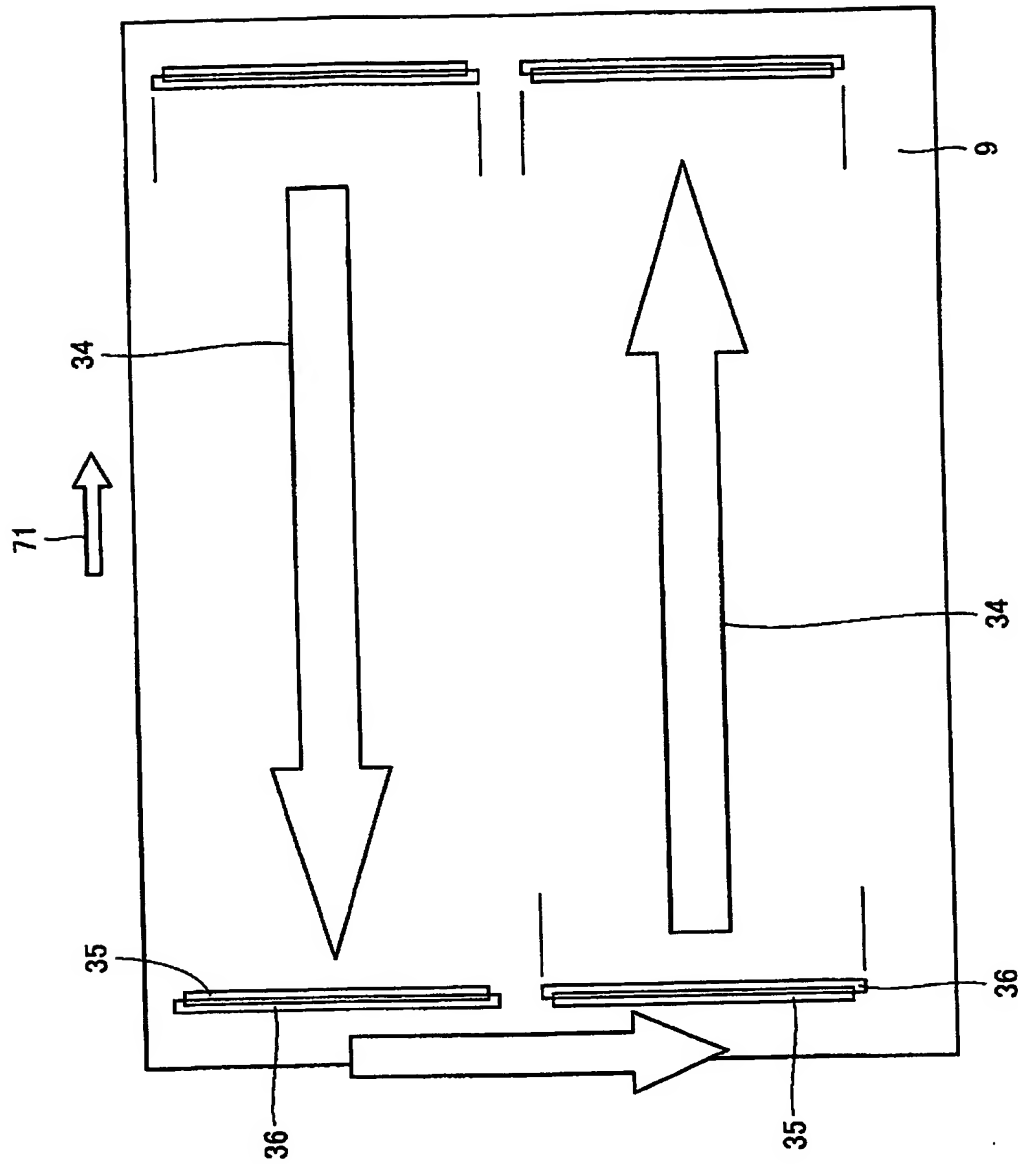
【図 12】



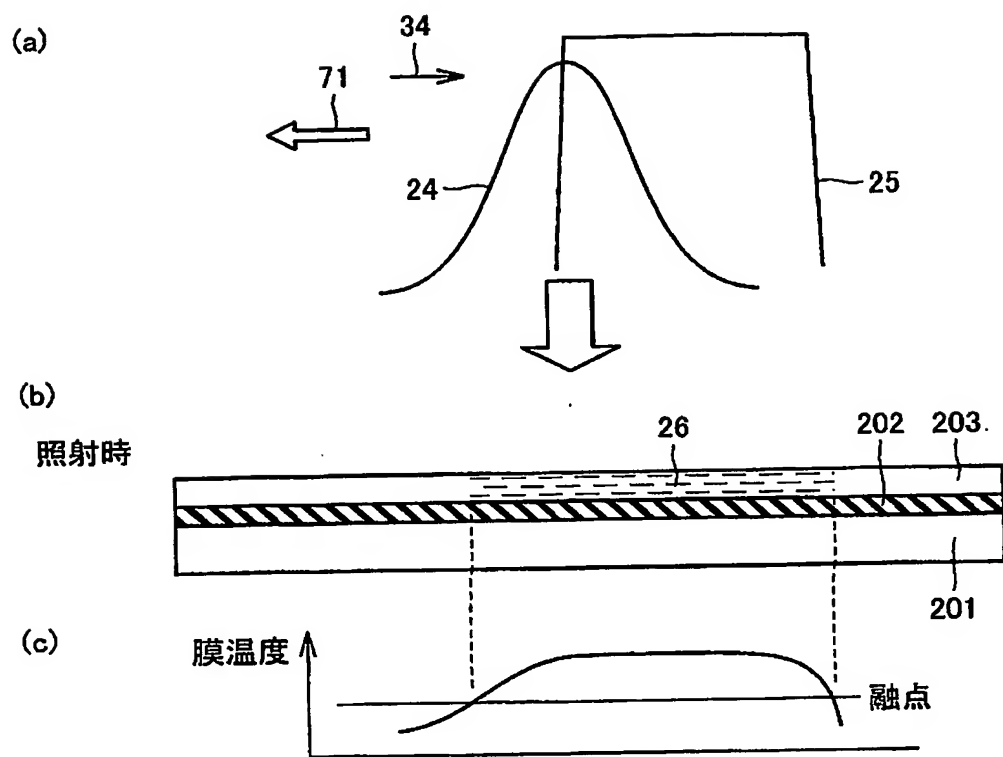
【図 13】



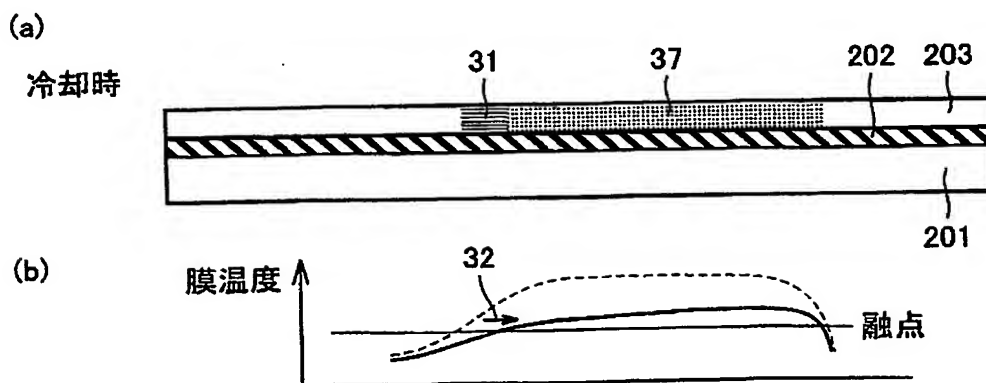
【図 14】



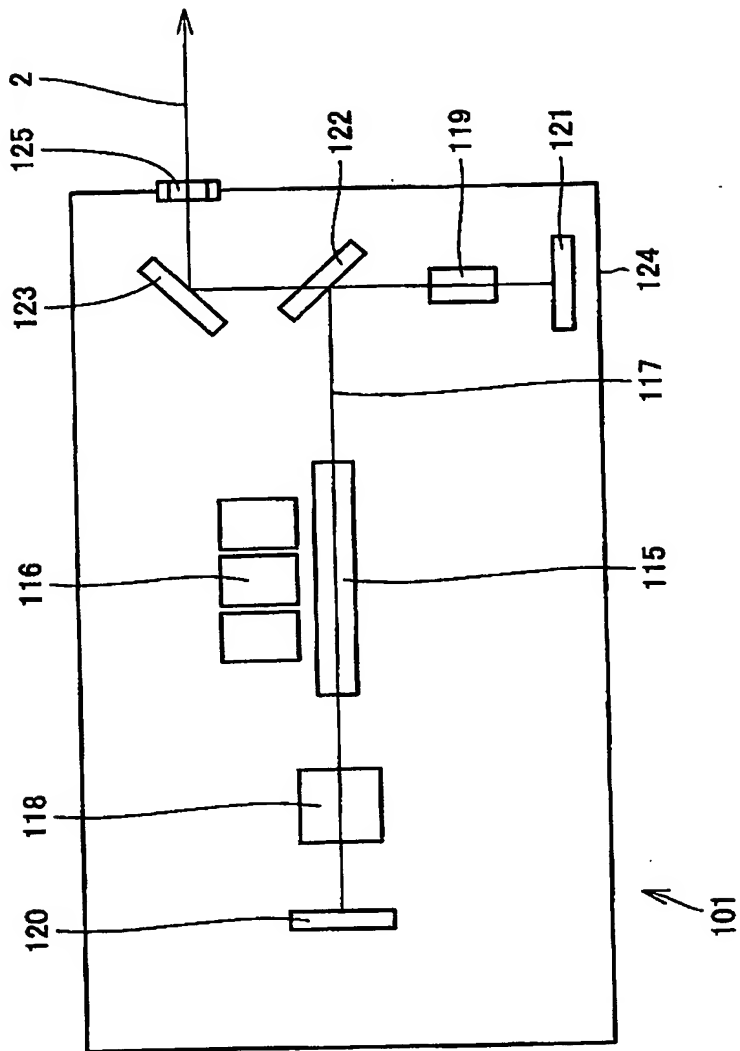
【図 15】



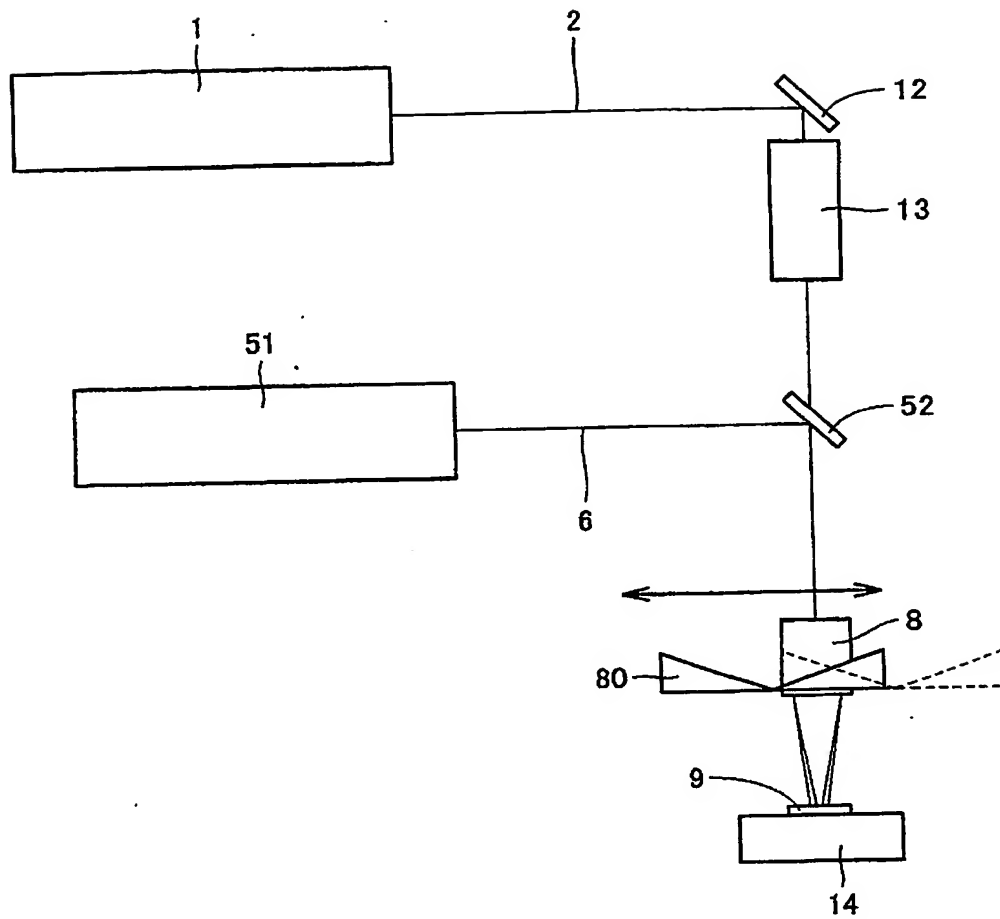
【図 16】



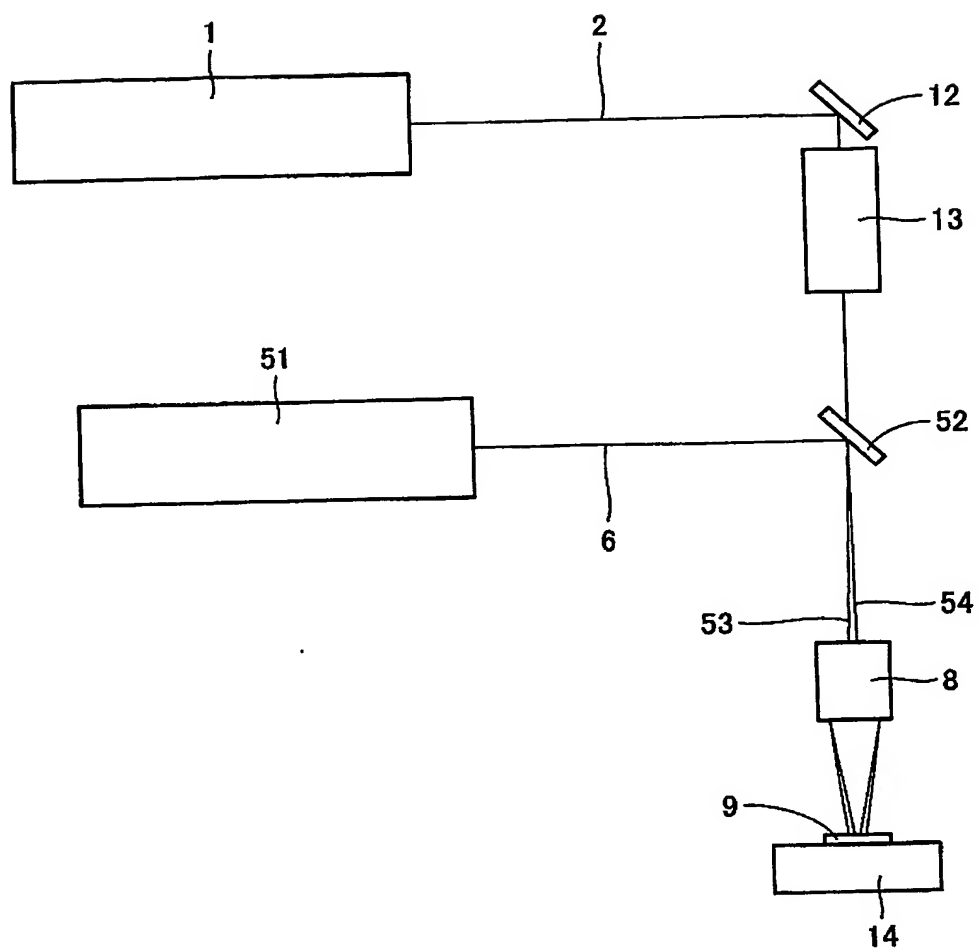
【図 17】



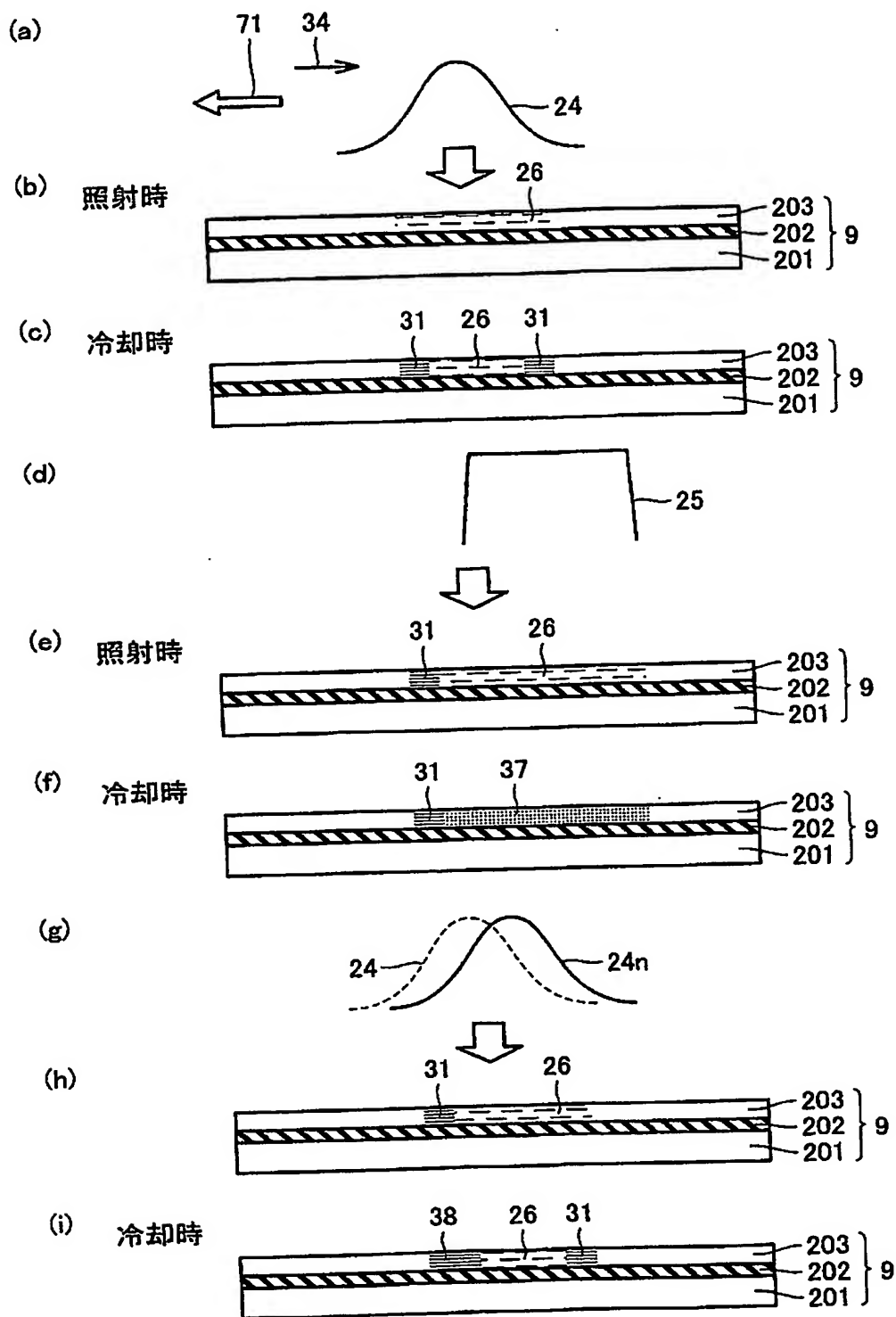
【図18】



【図 19】



【図 20】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 レーザ再結晶化方式で薄膜半導体を製造する際に、膜厚による制限を受けず、なおかつ、安定して大きな結晶粒径の多結晶シリコン膜を形成することができるようにする。

【解決手段】 薄膜半導体の製造方法は、可視光域に波長を有する第 1 のパルスレーザー光 2 2 を被照射物の表面に線形状に集光して、この線形状の照射領域 3 5 の幅方向に次のタイミングの照射領域 3 5 を重ね合わせるようにして位置をずらしながら繰返し照射して上記被照射物の表面に多結晶シリコン膜を形成する多結晶化工程を含み、この多結晶化工程は、第 1 のパルスレーザー光 2 2 が第 1 の照射領域 3 5 に照射されている間または照射される前に第 1 の照射領域 3 5 に部分的に重なる第 2 の照射領域 3 6 に紫外域に波長を有する第 2 のパルスレーザー光 2 3 を照射する。

【選択図】 図 8

特願 2 0 0 3 - 2 9 8 6 7 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 6 0 1 3]

1. 変更年月日
[変更理由]
住 所
氏 名

1 9 9 0 年 8 月 2 4 日
新規登録
東京都千代田区丸の内 2 丁目 2 番 3 号
三菱電機株式会社

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☒ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☒ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.